

○経済産業省告示第七十一号

貿易関係貿易外取引等に関する省令（平成十年通商産業省令第八号）第十条第三項の規定に基づき、令和六年経済産業省告示第七十八号（貿易関係貿易外取引等に関する省令第十条第三項の規定に基づく重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項）の一部を次の表のように改正し、令和八年八月十六日から施行する。

令和八年六月十六日

経済産業大臣 赤澤 亮正

（傍線部分は改正部分）

改正後	改正前
<p>二 この告示において「重要管理対象技術」とは、 外国為替令（昭和五十五年政令第二百六十号）別 表の一六の項の中欄に掲げる技術のうち、当該技 術を提供した後に、当該技術の提供を受けた者が</p>	<p>二 この告示において「重要管理対象技術」とは、 外国為替令（昭和五十五年政令第二百六十号）別 表の一六の項の中欄に掲げる技術のうち、当該技 術を提供した後に、当該技術の提供を受けた者が</p>

---

当該技術を内容とする情報を適切に管理しない場合において、省令第九条第二項第七号ロ若しくはニ又は第八号ロ若しくはニに規定するおそれが生じる技術であつて、次に掲げるものをいう。

イ 電子部品及びその製造に用いられるものの設計又は製造に係る技術であつて、次に掲げるものの

(一) ～ (六) (略)

(七) フィルム型のソルダーレジスト (回路基

板を被覆する絶縁材料として用いられるレ

ジストをいう。ハ (三) において同じ。)

---

当該技術を内容とする情報を適切に管理しない場合において、省令第九条第二項第七号ロ若しくはニ又は第八号ロ若しくはニに規定するおそれが生じる技術であつて、次に掲げるものをいう。

イ 電子部品及びその製造に用いられるものの設計又は製造に係る技術であつて、次に掲げるもの

(一) ～ (六) (略)

(新設)

---

---

の設計又は製造に係る技術

ロ (略)

ハ 半導体集積回路の製造に用いられるものの設計又は製造に係る技術であつて、次に掲げるものの

(一)・(二) (略)

(三) 液状型のソルダーレジストであつて、半導体の製造に用いられるものの設計又は製造に係る技術

(四) 窒化ガリウムの半導体基板又はインゴット、ブール若しくはその他のプリフォーム

---

ロ (略)

ハ 半導体集積回路の製造に用いられるものの設計又は製造に係る技術であつて、次に掲げるものの

(一)・(二) (略)

(新設)

(新設)

---

---

であつて、二十度の温度における電気抵抗率が百分の一オームセンチメートル以下のもの設計又は製造に係る技術

ニクチ (略)

リ 永久磁石の設計又は製造に係る技術

又 太陽電池及びその製造に用いられるもの設計又は製造に係る技術であつて、次に掲げるものの

- (一) ペロブスカイト構造を有する化合物を用いる太陽電池セル (以下この又において「ペロブスカイト太陽電池セル」という。)

ニクチ (略)

(新設)

(新設)

---

又はペロブスカイト太陽電池セルを直並列に接続した太陽電池モジュール（ペロブスカイト太陽電池セル以外の太陽電池セルを積層したものを含む。（二）において「ペロブスカイト太陽電池モジュール」という。）の設計又は製造に係る技術

（二）ペロブスカイト太陽電池セル又はペロブスカイト太陽電池モジュールの製造に用いられるレーザー加工機の設計又は製造に係る技術

ル 光学部品及びその製造に用いられるものの設

（新設）

計又は製造に係る技術であつて、次に掲げるもの

(一) エックス線検出のために用いられるシンチレータ（焼結体又はシート状のものに限る。）であつて出力される光のスペクトルの半値全幅が五〇ナノメートル未満のもの若しくはその製造に用いられる蛍光体の設計又は製造に係る技術

(二) (一) に規定するシンチレータ（焼結体のものに限る。）のアレイの設計又は製造に係る技術